

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН И ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ МГНОВЕННОМ СОЗДАНИИ ПЛАЗМЕННОГО СЛОЯ В ПОЛЕ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ

И. В. Осовицкая^{1,2}, В. А. Костин^{1,2}, Н. В. Введенский^{1,2}

Аналитически и численно рассчитаны частоты и амплитуды поверхностных волн, возбуждаемых при мгновенной ионизации слоя в поле р-поляризованной плоской волны, а также генерируемые в образующейся плазме квазипостоянные плотность тока и магнитное поле. В зависимости от параметров плазменного слоя и падающей волны, энергии, запасаемые в нечетных поверхностных волнах и статических полях и токе, могут значительно превосходить энергию четных волн, а возникающие квазипостоянные магнитные поля в плазме могут быть сопоставимы с амплитудой падающей волны.

Ключевые слова: ионизация, поверхностные волны, линейная трансформация волн, возбуждение токов в плазме.

Введение. Трансформация электромагнитных полей при их взаимодействии с нестационарной плазмой привлекает большой интерес в связи с различными приложениями, среди которых можно выделить генерацию излучения в различных частотных диапазонах (в том числе и недостаточно освоенных, таких как терагерцовый и средний инфракрасный) [1–13] и создание переключателей мощного СВЧ-излучения [14–16]. Нестационарная плазма при этом может создаваться коротким (фемтосекундным) ионизирующим оптическим импульсом, а в качестве преобразуемых полей выступать статическое электрическое поле, созданное конденсатором или системой конденсаторов [1, 2], мощное СВЧ-поле в свободном пространстве, резонаторе или волноводе [3–6], а также более

¹ Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 603022 Россия, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 23; e-mail: oivnn121@mail.ru.

² Институт прикладной физики РАН, 603950 Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46.

высокочастотные поля (напр., поле самого ионизирующего импульса) [7–13]. Значительное внимание уделяется линейной трансформации постоянных и переменных полей при сверхбыстром (по сравнению с характерными временами изменения преобразуемых полей) создании пространственно-ограниченных плазменных объектов, в частности, при оптическом возбуждении фотопроводника, взаимодействующего с мощным СВЧ-полем, (обычно рассматриваемого как основа для создания СВЧ-переключателей, управляемых зеркал и поляризаторов). Спектрально-модовая структура преобразованных полей в таких случаях может быть достаточно сложной и включать в себя как поверхностные и вытекающие волны дискретного спектра, так и излучение непрерывного спектра, а также квазипостоянные поля и токи в случае слабостолкновительной плазмы. При создании плазменных слоев обычно основное внимание уделяется возбуждению четных электрических (ТМ) поверхностных волн, а другие типы волн исследуются менее подробно.

В настоящей работе мы исследуем преобразование p -поляризованной плоской электромагнитной волны при ее взаимодействии с мгновенно возникшим плазменным слоем и анализируем возбуждение как четных, так и нечетных поверхностных ТМ-волн, а также генерацию квазипостоянной плотности электрического тока внутри слоя и соответствующего магнитного поля. Как показывает проведенный расчет, в зависимости от параметров плазменного слоя и падающей волны, энергии, запасаемые в нечетных поверхностных волнах и статических полях и токе, могут значительно превосходить энергию четных волн, а возникающие квазипостоянные магнитные поля в плазме могут быть сопоставимы с амплитудой падающей волны.

Постановка задачи и метод решения. Геометрия задачи показана на рис. 1. Изначально при времени $t < 0$ в свободном пространстве распространяется p -поляризованная однородная плоская электромагнитная волна заданной частоты ω_i под углом $0 < \alpha < \pi/2$ к отрицательному направлению оси x декартовой системы координат. Электрическое $\mathbf{E}^{(i)}$ и магнитное $\mathbf{B}^{(i)}$ поля в плоской волне задаются выражениями $\mathbf{E}^{(i)} = E_i \cos(\omega_i t + \kappa x - h z) (\sin \alpha \hat{\mathbf{x}} + \cos \alpha \hat{\mathbf{z}})$, $\mathbf{B}^{(i)} = E_i \cos(\omega_i t + \kappa x - h z) \hat{\mathbf{y}}$, где E_i – амплитуда плоской волны, $\kappa = (\omega_i/c) \cos \alpha$ и $h = (\omega_i/c) \sin \alpha$ – модули проекций волнового вектора \mathbf{k}_i , соответственно, на оси x и z , c – скорость света в вакууме, $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ и $\hat{\mathbf{z}}$ – единичные векторы декартовой системы координат. В момент времени $t = 0$ мгновенно возникает слой холодной однородной плазмы с плазменной частотой ω_p , занимающий область пространства $|x| < a$, где a – полутолщина слоя.

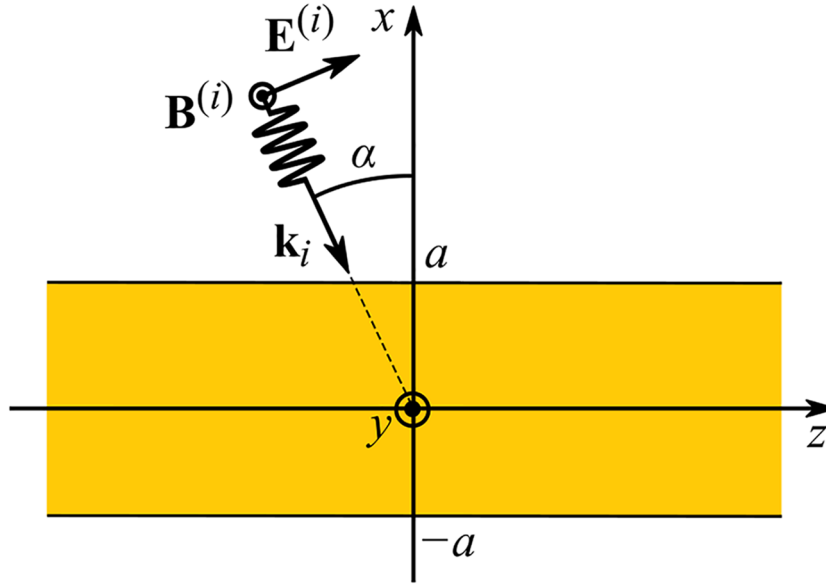


Рис. 1: Геометрия задачи. В поле монохроматической p -поляризованной однородной плоской волны с заданными электрическим $\mathbf{E}^{(i)}$ и магнитным $\mathbf{B}^{(i)}$ полями, волновым вектором \mathbf{k}_i и углом падения α мгновенно создается плазменный слой толщиной $2a$ в момент времени $t = 0$.

Электрическое \mathbf{E} и магнитное \mathbf{B} поля при $t > 0$ могут быть рассчитаны из системы уравнений Максвелла $\nabla \times \mathbf{B} = (4\pi/c)\mathbf{j} + (1/c)(\partial\mathbf{E}/\partial t)$, $\nabla \times \mathbf{E} = -(1/c)(\partial\mathbf{B}/\partial t)$ и линейного уравнения $\partial\mathbf{j}/\partial t = \omega_p^2\mathbf{E}/4\pi$ для плотности тока \mathbf{j} свободных электронов в холодной бесстолкновительной плазме внутри слоя, при $|x| < a$, вне слоя плотность тока отсутствует: $\mathbf{j} = 0$ для $|x| > a$. Указанные уравнения дополняются начальными условиями при $t = 0$, заключающимися в непрерывности электрического и магнитного полей и отсутствии плотности тока, а также принципом причинности, в соответствии с которым при $|x| - a < ct$ поля совпадают с полями исходной плоской волны $\mathbf{E}^{(i)}$ и $\mathbf{B}^{(i)}$. Для сшивки решений в однородных областях также необходимы условия непрерывности тангенциальных компонент полей B_y и E_z на границах возникшего плазменного слоя, при $x = \pm a$.

Решение поставленной задачи имеет гармоническую зависимость от z ($\partial^2/\partial z^2 = -h^2$) и не зависит от y ($\partial/\partial y \equiv 0$). Это решение может быть найдено с помощью преобразования Лапласа по времени t с лапласовской переменной s . В результате исходные уравнения с учетом начальных условий могут быть сведены к обыкновенному дифференциальному уравнению для лапласовского изображения \tilde{B}_y компоненты магнитного

поля B_y внутри и вне плазменного слоя

$$\varepsilon \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \tilde{B}_y}{\partial x} \right) - g^2 \tilde{B}_y = \frac{E_i}{c^2} [\omega_i \sin(\kappa x - hz) - s\varepsilon \cos(\kappa x - hz)], \quad (1)$$

где $g^2(x) = h^2 + s^2\varepsilon(x)/c^2$ – квадрат поперечного волнового числа, $\varepsilon(x) = 1$ при $|x| > a$, $\varepsilon(x) = \varepsilon_p$ при $|x| < a$, $\varepsilon_p = 1 + \omega_p^2/s^2$ – комплексная диэлектрическая проницаемость плазмы.

Результаты и их обсуждение. Решение уравнения (1) с учетом граничных условий при $x = \pm a$ и принципа причинности имеет вид $\tilde{B}_y = \tilde{B}_y^{(e)} + \tilde{B}_y^{(o)}$, где лапласовские изображения $\tilde{B}_y^{(e)}$ и $\tilde{B}_y^{(o)}$ четной и нечетной компонент (по x) соответственно определяются выражениями

$$\tilde{B}_y^{(e)} = \tilde{b}_e \cos \kappa x + \tilde{b}_o q \times \begin{cases} (f_e - \cos \kappa a) e^{-g_v(|x|-a)} & \text{для } |x| > a, \\ f_e \frac{\cosh g_p x}{\cosh g_p a} - \cos \kappa x & \text{для } |x| < a; \end{cases}$$

$$\tilde{B}_y^{(o)} = \tilde{b}_o \sin \kappa x + \tilde{b}_e q \times \begin{cases} \operatorname{sgn} x (f_o + \sin \kappa a) e^{-g_v(|x|-a)} & \text{для } |x| > a, \\ f_o \frac{\sinh g_p x}{\sinh g_p a} + \sin \kappa x & \text{для } |x| < a, \end{cases}$$

где $g_v = \sqrt{h^2 + s^2/c^2}$ и $g_p = \sqrt{h^2 + s^2\varepsilon_p/c^2}$ (знак перед квадратным корнем в g_v выбирается так, чтобы $\operatorname{Re} g_v > 0$ в области абсолютной сходимости лапласовских изображений $\operatorname{Re} s > 0$; знак перед квадратным корнем в g_p выбирается произвольным образом), $q = \omega_i s(\varepsilon_p - 1)/(\omega_i^2 + s^2\varepsilon_p)$,

$$\tilde{b}_e = E_i \frac{s \cos hz + \omega_i \sin hz}{s^2 + \omega_i^2}, \quad \tilde{b}_o = E_i \frac{s \sin hz - \omega_i \cos hz}{s^2 + \omega_i^2},$$

$$f_e = \frac{\varepsilon_p}{\Delta_e} \left(\frac{s^2}{\omega_i^2} \kappa a \sin \kappa a + g_v a \cos \kappa a \right), \quad f_o = \frac{\varepsilon_p}{\Delta_o} \left(\frac{s^2}{\omega_i^2} \kappa a \cos \kappa a - g_v a \sin \kappa a \right),$$

$$\Delta_e = g_p a \tanh g_p a + \varepsilon_p g_v a, \quad \Delta_o = g_p a \coth g_p a + \varepsilon_p g_v a.$$

Полученные лапласовские изображения допускают аналитическое продолжение на комплексную плоскость лапласовской переменной s с разрезом, соединяющим точки ветвления $s = \pm ich$ через бесконечность по мнимой оси. С помощью теоремы Коши о вычетах, интеграл Меллина, определяющий оригиналы полей и токов при $t > 0$, может быть представлен в виде суперпозиции 1) решения на частоте плоской волны ω_i , представляющего собой известное решение задачи об отражении плоской монохроматической волны от стационарного плазменного слоя; 2) волн непрерывного спектра – излучающей составляющей, которая может быть представлена в виде спектрального

интеграла по частотам, большим ch ; 3) плотности статического тока и создаваемого ей магнитного поля внутри плазменного слоя и 4) четной и нечетной поверхностных ТМ-волн, бегущих вдоль оси z в положительном и отрицательном направлениях. Далее рассмотрим последние две составляющие, которые определяют незатухающие собственные волны при $t \rightarrow \infty$.

Компоненты статического магнитного поля $\mathbf{B}^{(0)} = B_y^{(0)} \hat{\mathbf{y}}$ и плотности тока $\mathbf{j}^{(0)} = j_x^{(0)} \hat{\mathbf{x}} + j_z^{(0)} \hat{\mathbf{z}}$ находятся как соответствующие вычеты лапласовских изображений при $s = 0$ и выражаются следующим образом:

$$\begin{aligned} B_y^{(0)} &= \frac{E_i \omega_p^2}{\omega_i^2 + \omega_p^2} \left[\cos(hz - \kappa x) - \sin \kappa a \sin hz \frac{\sinh g_p^{(0)} x}{\sinh g_p^{(0)} a} - \cos \kappa a \cos hz \frac{\cosh g_p^{(0)} x}{\cosh g_p^{(0)} a} \right], \\ j_x^{(0)} &= \frac{E_i c h \omega_p^2}{4\pi (\omega_i^2 + \omega_p^2)} \left[\sin(hz - \kappa x) + \sin \kappa a \cos hz \frac{\sinh g_p^{(0)} x}{\sinh g_p^{(0)} a} - \cos \kappa a \sin hz \frac{\cosh g_p^{(0)} x}{\cosh g_p^{(0)} a} \right], \\ j_z^{(0)} &= \frac{E_i c g_p^{(0)} \omega_p^2}{4\pi (\omega_i^2 + \omega_p^2)} \left[\frac{\kappa}{g_p^{(0)}} \sin(hz - \kappa x) - \sin \kappa a \sin hz \frac{\cosh g_p^{(0)} x}{\sinh g_p^{(0)} a} - \cos \kappa a \cos hz \frac{\sinh g_p^{(0)} x}{\cosh g_p^{(0)} a} \right], \end{aligned}$$

где $g_p^{(0)} = g_p|_{s=0} = \sqrt{h^2 + \omega_p^2/c^2}$. В тонких слоях, $\omega_{p,i} \ll c/a$, статическое магнитное поле $|\mathbf{B}^{(0)}|$ достигает максимального значения $(E_i/2)(\omega_p a/c)^2 \ll E_i$ в середине слоя при $x = 0$ и $z = \pi n/h$, где n – целое. В более толстых слоях магнитное поле может быть сопоставимо с E_i и даже превосходить это значение, в частности, при $\omega_p \gg \omega_i \gg a/c$ статическое магнитное поле приближенно повторяет распределение амплитуды поля исходной волны внутри слоя (за исключением узких областей вблизи границ слоя). Запасенная в статических магнитном поле и плотности тока энергия, приходящаяся на единицу площади плазменного слоя, может быть найдена прямым интегрированием и определяется выражением

$$W_0 = \frac{E_i^2 a}{8\pi} \frac{\omega_p^2}{\omega_i^2 + \omega_p^2} \left[1 + \frac{c^2 g_p^{(0)} (3\omega_i^2 - \omega_p^2) (\cosh 2g_p^{(0)} a - \cos 2\kappa a)}{a (\omega_i^2 + \omega_p^2)^2 \sinh 2g_p^{(0)} a} \right] < W_i/2, \quad (2)$$

где $W_i = E_i^2 a/4\pi$ – приходящаяся на единицу площади плазменного слоя энергия исходной плоской волны внутри слоя $|x| < a$.

Частоты четной ω_{se} и нечетной ω_{so} поверхностных волн удовлетворяют соответственно дисперсионным соотношениям $\Delta_e|_{s=-i\omega_{se}} = 0$ и $\Delta_o|_{s=-i\omega_{so}} = 0$, где $g_{v,p}^{(se,so)} = g_{v,p}|_{s=-i\omega_{se,so}}$. Эти частоты при любых параметрах удовлетворяют неравенствам $0 < \omega_{so} < \omega_{se} < \omega_p$, ch . Анализируя вычеты $\tilde{B}_y e^{st}$ при $s = \pm i\omega_{se,so}$, находим магнитные

поля четной $B_y^{(se)}$ и нечетной $B_y^{(so)}$ поверхностных волн:

$$B_y^{(se)} = \left[A_+^{(se)} \cos(\omega_{se}t - hz) + A_-^{(se)} \cos(\omega_{se}t + hz) \right] \times \begin{cases} e^{-g_v^{(se)}(|x|-a)} & \text{для } |x| > a, \\ \frac{\cosh g_p^{(se)} x}{\cosh g_p^{(se)} a} & \text{для } |x| < a, \end{cases}$$

$$B_y^{(so)} = \left[A_+^{(so)} \cos(\omega_{so}t - hz) + A_-^{(so)} \cos(\omega_{so}t + hz) \right] \times \begin{cases} \operatorname{sgn} x e^{-g_v^{(so)}(|x|-a)} & \text{для } |x| > a, \\ \frac{\cosh g_p^{(so)} x}{\cosh g_p^{(so)} a} & \text{для } |x| < a, \end{cases}$$

где $A_{\pm}^{(se,so)}$ – амплитуды поверхностных волн, бегущих в положительном и отрицательном направлениях оси z ,

$$A_{\pm}^{(se)} = E_i \frac{c^2 h^2 - \omega_{se}^2}{\omega_i^2 - \omega_{se}^2} \frac{\omega_p^2 + c^2 h^2 - \omega_{se}^2}{\omega_p^2 + \omega_i^2 - \omega_{se}^2} \frac{\omega_i (\omega_i \pm \omega_{se}) (\omega_p^2 - \omega_{se}^2)}{P(-i\omega_{se})} \left(\cos \kappa a - \frac{\omega_{se}^2}{\omega_i^2} \frac{\kappa}{g_v^{(se)}} \sin \kappa a \right),$$

$$A_{\pm}^{(so)} = E_i \frac{c^2 h^2 - \omega_{so}^2}{\omega_i^2 - \omega_{so}^2} \frac{\omega_p^2 + c^2 h^2 - \omega_{so}^2}{\omega_p^2 + \omega_i^2 - \omega_{so}^2} \frac{\omega_i (\mp \omega_i - \omega_{so}) (\omega_p^2 - \omega_{so}^2)}{P(-i\omega_{so})} \left(\sin \kappa a + \frac{\omega_{so}^2}{\omega_i^2} \frac{\kappa}{g_v^{(se)}} \cos \kappa a \right),$$

$$P(s) = (s^2 + c^2 h^2) (s^2 + \omega_p^2 + 2c^2 h^2) + c^2 h^2 (s^2 + \omega_p^2) + g_v a [s^2 (s^2 + \omega_p^2) + c^2 h^2 (2s^2 + \omega_p^2)].$$

Заметим, что амплитуды $A_+^{(se,so)}$ поверхностных волн, бегущих в положительном направлении оси z , не превышают $2E_i$, но могут быть достаточно близки к этому значению в тонких слоях. Максимальное значение амплитуд $A_-^{(se,so)}$ поверхностных волн, бегущих в отрицательном направлении оси z , близко к $0.12E_i$ и достигается в толстых слоях. Полные энергии $W^{(se,so)}$ четной и нечетной поверхностных волн на единицу площади слоя складываются из энергий $W_{\pm}^{(se,so)}$ соответствующих волн, бегущих в противоположных направлениях вдоль оси z : $W^{(se,so)} = W_+^{(se,so)} + W_-^{(se,so)}$,

$$W_{\pm}^{(se,so)} = \frac{A_{\pm}^{(se,so)2}}{8\pi g_v^{(se,so)}} \frac{\omega_p^2 P(-i\omega_{se,so})}{\omega_{se,so}^2 (\omega_p^2 - \omega_{se,so}^2) (\omega_i^2 \sin^2 \alpha + \omega_p^2 - \omega_{se,so}^2)}. \quad (3)$$

Как видно, всегда $W_+^{(se,so)} > W_-^{(se,so)}$ и в целом поток энергии направлен в положительном направлении оси z . При этом при любых параметрах $W_-^{(se)}/W_i < 1/6$, в то время как отношения $W_+^{(se)}/W_i$ и $W_-^{(so)}/W_i$ могут быть сколь угодно велики (хотя с ростом этих отношений следует ожидать и рост времени установления найденных стационарных решений).

На рис. 2 представлены результаты численных расчетов частот четной ω_{se} и нечетной ω_{so} поверхностных волн, их энергий $W^{(se,so)}$, и энергии W_0 статической компоненты

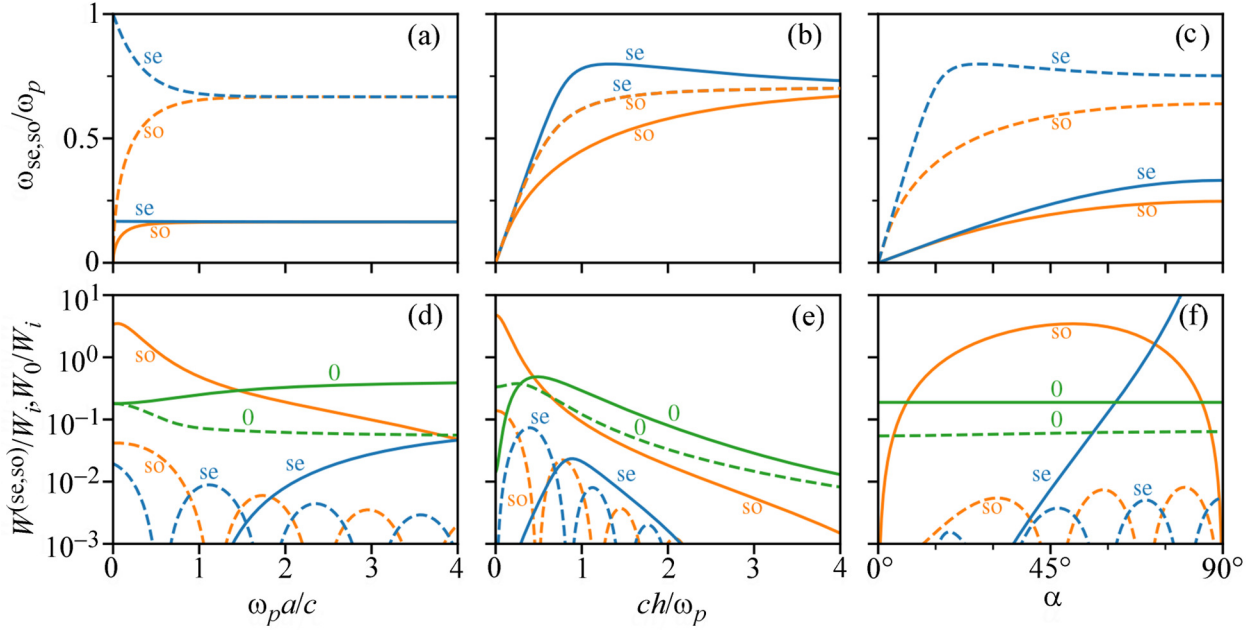


Рис. 2: ((a)–(c)) – найденные с помощью численного решения дисперсионных уравнений частоты ω_{se} и ω_{so} четной (кривые *se*) и нечетной (кривые *so*) поверхностных волн, нормированные на плазменную частоту ω_p , и ((d)–(f)) – найденные с помощью формул (2) и (3) энергии $W^{(se)}$, $W^{(so)}$ и W_0 , запасенные соответственно в четной (кривые *se*), нечетной (кривые *so*) поверхностных волнах и статической компоненте решения (кривые 0) на единицу площади слоя, нормированные на энергию W_i исходной волны внутри слоя, приходящаяся на единицу его площади, в зависимости от ((a), (d)) безразмерной полутолщины слоя $\omega_p a/c$, ((b), (e)) безразмерного продольного волнового числа ch/ω_p и ((c), (f)) угла падения плоской волны α . Для сплошных кривых $\omega_i/\omega_p = 1/3$, $\alpha = 30^\circ$ на панелях ((a), (d)); $\omega_p a/c = 1/3$, $\alpha = 30^\circ$ на панелях ((b), (e)); $\omega_p a/c = 1/3$, $\omega_i/\omega_p = 1/3$ на панелях ((c), (f)). Для пунктирных кривых $\omega_i/\omega_p = 3$, $\alpha = 30^\circ$ на панелях ((a), (d)); $\omega_p a/c = 3$, $\alpha = 30^\circ$ на панелях ((b), (e)); $\omega_p a/c = 3$, $\omega_i/\omega_p = 3$ на панелях ((c), (f)).

в зависимости от безразмерной толщины слоя $\omega_p a/c$, безразмерного продольного волнового числа ch/ω_p и угла падения плоской волны α . Как видно, энергия $W^{(se)}$ оказывается наибольшей при α , близких к $\pi/2$, и $\omega_p a/c \ll 1$. Энергия $W^{(so)}$ может оказаться наибольшей при малых значениях ch/ω_p . Заметим, что энергия W_0 может на несколько порядков превосходить энергию, запасаемую в поверхностных волнах, для больших значений ch/ω_p .

Заключение. В работе исследовано преобразование p -поляризованной плоской электромагнитной волны в поверхностные волны и постоянный ток при мгновенном создании плазменного слоя. Получены аналитические выражения для электромагнитных полей четной и нечетной поверхностных волн и постоянного магнитного поля и тока в плазменном слое, а также рассчитаны и сопоставлены энергии, запасенные в поверхностных волнах разной четности и постоянных магнитном поле и плотности тока. В зависимости от параметров плазменного слоя (его толщины и плазменной частоты) и преобразуемой плоской волны (ее частоты и угла падения) любая из энергий может оказаться наибольшей.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 18-11-00210.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- [1] A. Houard, Y. Liu, B. Prade, et al., Phys. Rev. Lett. **100**, 255006 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.255006.
- [2] V. A. Kostin, N. V. Vvedenskii, New J. Phys. **17**, 033029 (2015). DOI: 10.1088/1367-2630/17/3/033029.
- [3] А. М. Быстров, Н. В. Введенский, В. Б. Гильденбург, Письма в ЖЭТФ **82**, 852 (2005). DOI: 10.1134/1.2175243.
- [4] M. I. Bakunov, A. V. Maslov, Phys. Rev. Lett. **79**, 4585 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevLett.79.4585.
- [5] M. I. Bakunov, A. V. Maslov, Phys. Rev. E **57**, 5978 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevE.57.5978.
- [6] A. V. Maslov, M. I. Bakunov, A. A. Erykalin, Phys. Rev. E **103**, 043207 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevE.103.043207.
- [7] V. B. Gildenburg, N. V. Vvedenskii, Phys. Rev. Lett. **98**, 245002 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.245002.
- [8] A. Nishida, N. Yugami, T. Higashiguchi, et al., Appl. Phys. Lett. **101**, 161118 (2012). DOI: 10.1063/1.4755843.
- [9] V. A. Kostin, N. V. Vvedenskii, Phys. Rev. Lett. **120**, 065002 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.065002.
- [10] I. Thiele, B. Zhou, A. Nguyen, et al., Optica **5**, 1617 (2018). DOI: 10.1364/OPTICA.5.001617.

- [11] А. А. Силаев, В. А. Костин, И. Д. Ларюшин, Н. В. Введенский, Письма в ЖЭТФ **107**, 160 (2018). DOI: 10.1134/S002136401803013X.
- [12] А. А. Frolov, Phys. Plasmas **28**, 013104 (2019). DOI: 10.1063/5.0033225.
- [13] А. А. Frolov, Plasma Phys. Control. Fusion **63**, 085014 (2021). DOI: 10.1088/1361-6587/AC08F5.
- [14] А. А. Вихарев, Г. Г. Денисов, В. В. Кочаровский и др., Письма в ЖТФ **33**, 38 (2007). DOI: 10.1134/S1063785007090064.
- [15] M. Kulygin, G. Denisov, K. Vlasova, et al., Rev. Sci. Instrum. **87**, 014704 (2016). DOI: 10.1063/1.4939673.
- [16] J. F. Picard, S. C. Schaub, G. Rosenzweig, et al., Appl. Phys. Lett. **114**, 164102 (2019). DOI: 10.1063/1.5093639.

Поступила в редакцию 18 ноября 2021 г.

После доработки 18 ноября 2021 г.

Принята к публикации 5 марта 2022 г.